

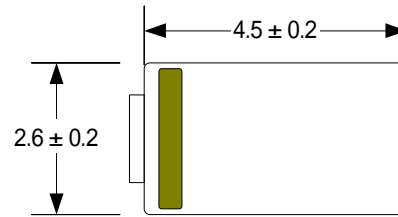
SJPZ-E33  
Power Zener Diode

2009年4月

概要

過電圧保護素子として優れた応答性で動作する表面実装型 1W パワーゼナーダイオードです

パッケージ



アプリケーション

- ・カービ
- ・エアパック
- ・その他電子機器

主要スペック

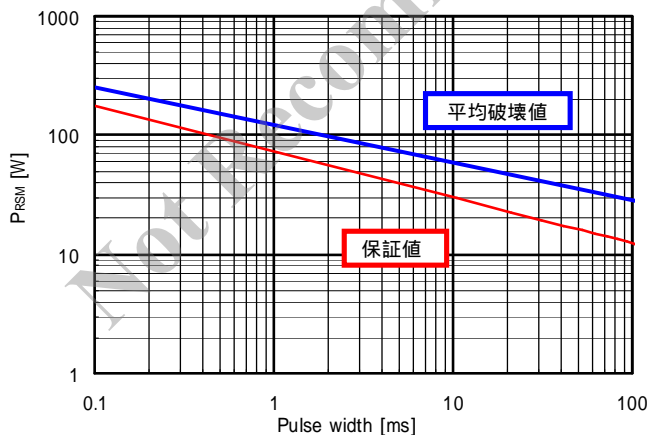
項目	記号	単位	定格	条件
許容電力損失	P	W	1	ガラス球形 基板実装
ピーク逆耐電力	$P_{RSM}$	W	95 min	500 $\mu$ s 矩形波 単発
逆方向降伏電圧	$V_Z$	V	31.0 ~ 35.0	$I_Z=1mA$
逆方向漏れ電流	$I_R$	$\mu$ A	10 max	$V_R=25V$

特長

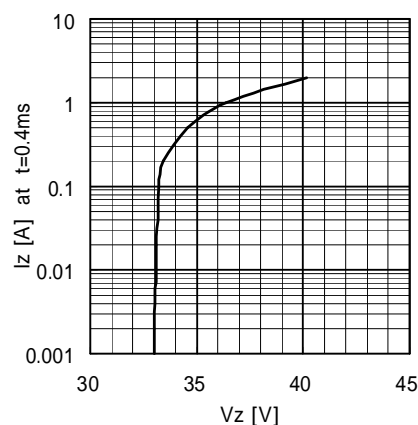
- ・平均電力損失 1W の 2 端子面実装型
- ・高逆サージ耐量と高 ESD 耐量を確保

代表特性

ピーク逆耐電力破壊値  $P_{RSM}$



逆方向降伏電圧 - 逆方向降伏電流特性  $V_Z - I_Z$   
 $V_Z$  typ.品 at  $I_Z=1mA$



**SJPZ-E33**  
Power Zener Diode

2009 年 4 月

★ 絶対最大定格

製品名			SJPZ-E33	
項 目	記号	単位	定 格	条 件
許容電力損失	P	W	1	次頁の図 P - T a 参照
パルス逆耐電力	P <sub>RSM</sub>	W	95 min.	500 μs 矩形波単発
接合部温度	T <sub>j</sub>		-55 ~ +150	-
保存温度	T <sub>stg</sub>		-55 ~ +150	-

★ 電気的特性(特に指定の無い場合は、25℃とする。)

製品名			SJPZ-E33	
項 目	記号	単位	定 格	条 件
逆方向降伏電圧	V <sub>Z</sub>	V	31.0 ~ 35.0	I <sub>Z</sub> =1mA
逆方向漏れ電流	I <sub>R</sub>	μA	10 max.	V <sub>R</sub> =25V
降伏電圧温度依存性	z	mV/	28 typ.	I <sub>Z</sub> =1mA
降伏領域等価抵抗	R <sub>Z</sub>		10 typ.	I <sub>Z</sub> =10mA ~ 20mA

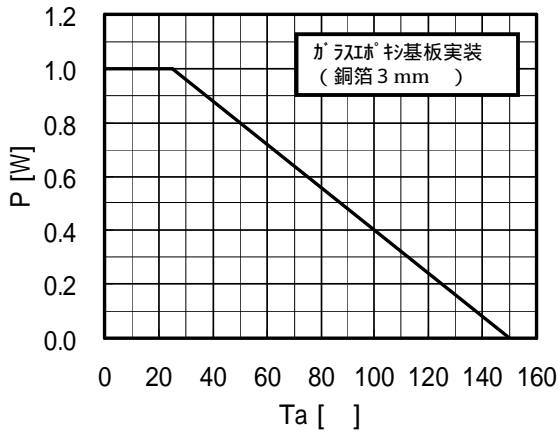
**SJPZ-E33**

2009 年 4 月

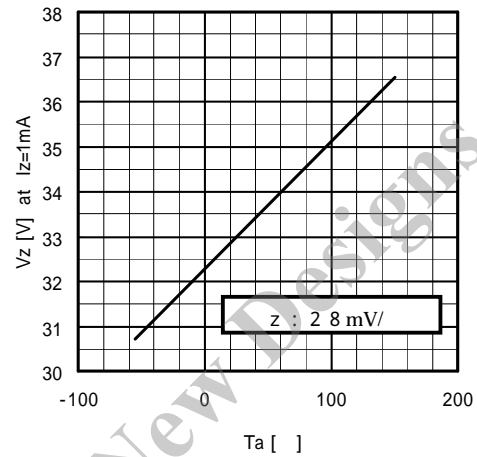
Power Zener Diode

★ 特性

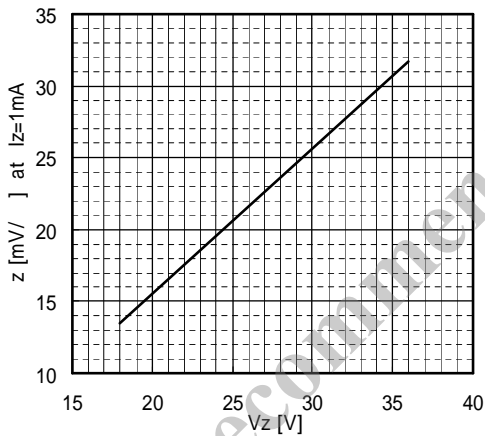
許容電力損失 - 周囲温度特性 P - Ta



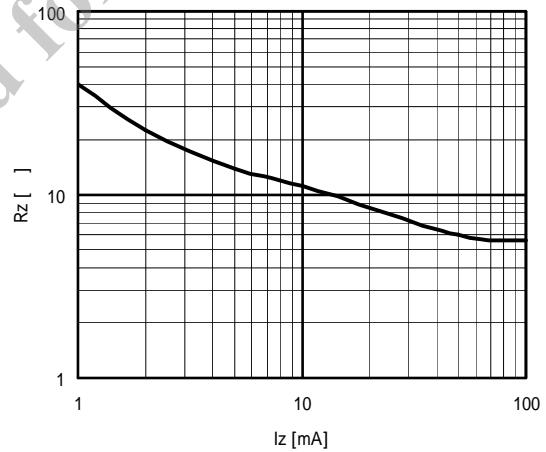
逆方向降伏電圧 - 周囲温度特性 Vz - Ta  
Vz typ.品 at Iz=1mA



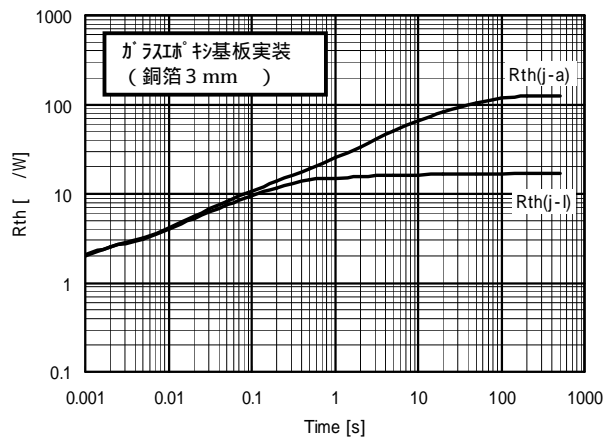
逆方向降伏電圧 - 降伏電圧温度係数特性 Vz - z



降伏領域等価抵抗 - 逆方向降伏電流特性 Rz - Iz  
Vz typ.品 at Iz=1mA



過渡熱抵抗特性 Rth

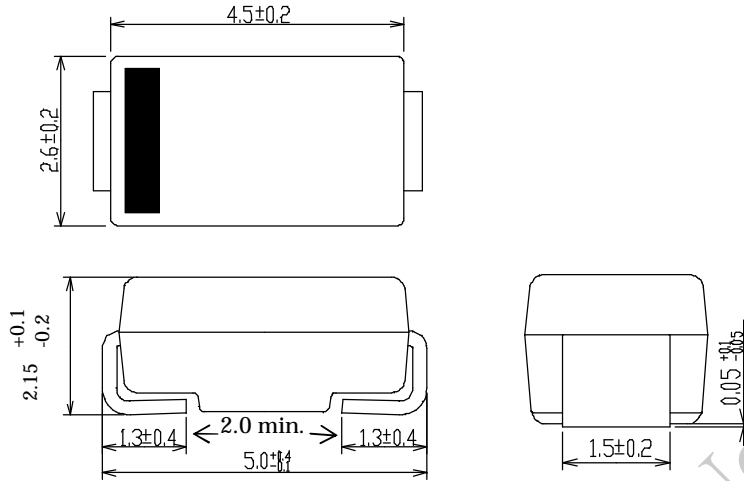


**SJPZ-E33**

2009年4月

Power Zener Diode

外形図 (mm)



接続図

